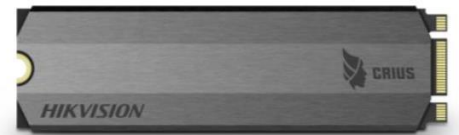


SSD Serie E2000

Introducción

El SSD E2000 adopta la interfaz M.2, el chip informático de control SSD avanzado y el flash NAND 3D para mejorar de manera efectiva la velocidad R/W y garantizar la seguridad de los datos.



Se aplica a computadoras personales y servidores proxy de tamaño pequeño para brindar un servicio estable y de alta velocidad. También puede mejorar la experiencia de juego de alta gama y el rendimiento de edición de gráficos 3D.

Modelos Disponibles

HS-SSD-E2000 256GB

HS-SSD-E2000 512GB

HS-SSD-E2000 1024GB

HS-SSD-E2000 2048GB

Aplicación Típica

- PC (Portátil y Escritorio)
- Servidor proxy de tamaño pequeño

Características y Funciones

- **Alta velocidad R/W**
Soporta PCIe y NVMe
Max. velocidad de lectura de hasta 3300 MB/s
- **3D NAND**
Adopta flash 3D NAND para optimizar la capacidad, el rendimiento y estabilidad
- **A prueba de choques**
Sin estructura mecánica
Adopta control de chips electrónicos
Alta seguridad de datos
- **Interfaz M.2**



Especificaciones

Modelo	HS-SSD-E1000				
Capacidad	256GB	512GB	1024GB	2048GB	
Forma de Factor	M.2 (NGFF)				
Interfaz	PCIe Gen3x4, NVMe				
Memoria caché DRAM	Soporta				
Dimensiones	80.15 mm × 22.15 mm × 2.38 mm				
Max. velocidad de lectura secuencial de 128 K ❶	3000 MB/s	3400 MB/s	3300 MB/s	3300 MB/s	
Max. velocidad de escritura secuencial de 128 K	1300 MB/s	2600 MB/s	2800 MB/s	3000 MB/s	
Max. IOPS de lectura aleatoria de 4 K ❷	194 K	195 K	193 K	115 K	
Max. IOPS de escritura aleatoria de 4 K	266 K	265 K	215 K	325 K	
Consumo de Potencia ❸	Lectura (RMS máx.)	3.96 W	3.96 W	3.96 W	3.96 W
	Escritura (RMS máx.)	6.4 W	7 W	7.2 W	7.2 W
Resistencia (TBW) ❹	160 TB	320 TB	640 TB	1280 TB	
Memoria flash NAND	3D TLC				
Peso	≤ 8 g				
MTBF (tiempo medio entre fallos) ❺	2,000,000 h				
Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)				
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)				
Humedad de Operación	5% a 95% (Sin condensación)				
Período de garantía limitada	3 años				

*: La prueba de rendimiento se realiza en un entorno de prueba específico. Cualquier cambio de sistema informático, sistema operativo, hardware, software o funciones influirá en el resultado de la prueba.

❶ ❷: El rendimiento en las especificaciones se prueba basados en CrystalDiskMark.

❸: El consumo de energía puede variar según la configuración y la plataforma flash. Los consumos de energía se miden usando CrystalDiskMark 1000 MB para probar secuencial R / W 5 veces. Los consumos de energía se miden cuando la lectura secuencial [1/5] a [5/5] y la escritura secuencial [1/5] a [5/5].

❹: El valor de TBW se calcula en función de la carga de trabajo de JEDC 218B / 219A estándar.

❺: El valor de MTBF se calcula en función de la tasa de falla funcional del estándar JEDC 218B / 219A.

Distributed by



Headquarters
Room 307, Unit B, Building 2,
399 Danfeng Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China